

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

5 V, シリコン・ゲルマニウム中出力高周波広帯域増幅器 IC

μ PC3232TB は LNB など IF 増幅用に開発したシリコン・ゲルマニウム・モノリシック IC です。

本製品は, $f_{\max} = 50$ GHz の当社独自のシリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセス「UHS2」(Ultra High Speed Process) により生産しています。

特 徴

- 低消費電流 : $I_{CC} = 26.0$ mA TYP.
- 中出力電力 : $P_{O(sat)} = +15.5$ dBm TYP. @ $f = 1.0$ GHz
: $P_{O(sat)} = +12.0$ dBm TYP. @ $f = 2.2$ GHz
- 高いリニアリティ : $P_{O(1\text{ dB})} = +11.0$ dBm TYP. @ $f = 1.0$ GHz
: $P_{O(1\text{ dB})} = +8.5$ dBm TYP. @ $f = 2.2$ GHz
- 電力利得 : $G_P = 32.8$ dB MIN. @ $f = 1.0$ GHz
: $G_P = 33.5$ dB MIN. @ $f = 2.2$ GHz
- ゲイン・フラットネス : $\Delta G_P = 1.0$ dB TYP. @ $f = 1.0 \sim 2.2$ GHz
- 雑音指数 : $NF = 4$ dB TYP. @ $f = 1.0$ GHz
: $NF = 4.1$ dB TYP. @ $f = 2.2$ GHz
- 電源電圧 : $V_{CC} = 4.5 \sim 5.5$ V
- 特性インピーダンス : 入出力 $50\ \Omega$

用 途

- DBS 用 LNB の IF 増幅器など

オーダ情報

品名	オーダ名称	パッケージ	捺印	包装形態
μ PC3232TB-E3	μ PC3232TB-E3-A	6 ピン小型ミニモールド (鉛フリー)	C3S	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング ・ 1, 2, 3 ピン側が送り丸穴 ・ 3 k 個 / リール

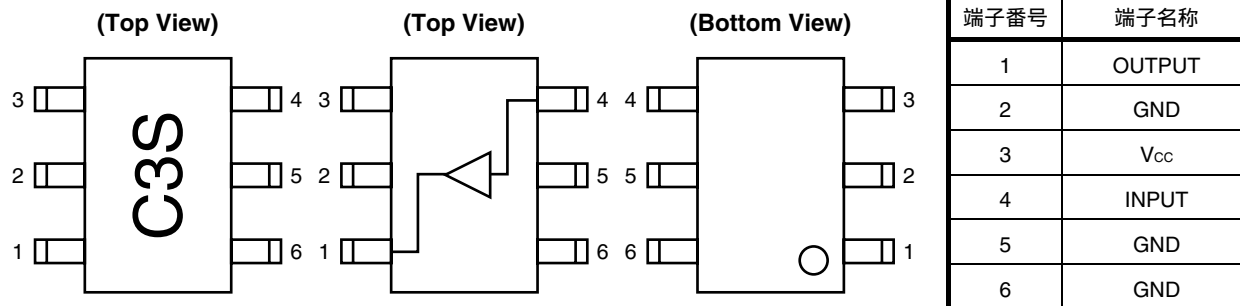
備考 評価用サンプルのオーダについては, 販売員にお問い合わせください。

サンプル名称: μ PC3232TB

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので, 取り扱いに注意してください。

本資料の内容は, 予告なく変更することがありますので, 最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図および内部ブロック図



5 V, シリコン高周波中出力増幅器の製品系列一覧

(T_A = +25°C, f = 1 GHz, V_{cc} = V_{out} = 5.0 V, Z_s = Z_L = 50 Ω)

品 名	P _{O(sat)} (dBm)	G _P (dB)	NF (dB)	I _{cc} (mA)	パッケージ	捺 印
μ PC2708TB	+ 10.0	15.0	6.5	26	6 ピン小型ミニモールド	C1D
μ PC2709TB	+ 11.5	23.0	5.0	25		C1E
μ PC2710TB	+ 13.5	33.0	3.5	22		C1F
μ PC2776TB	+ 8.5	23.0	6.0	25		C2L
μ PC3223TB	+ 12.0	23.0	4.5	19		C3J
μ PC3225TB	+ 15.5 ^注	32.5 ^注	3.7 ^注	24.5		C3M
μ PC3226TB	+ 13.0	25.0	5.3	15.5		C3N
μ PC3232TB	+ 15.5	32.8	4.0	26		C3S

注 μ PC3225TB は, f = 0.95 GHz

備考 主要項目の TYP. 値。規格条件は電気的特性欄を参照

絶対最大定格

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
電源電圧	V _{CC}	T _A = +25°C	6.0	V
Total 回路電流	I _{CC}	T _A = +25°C	45	mA
パッケージ許容損失	P _D	T _A = +85°C 注	270	mW
動作周囲温度	T _A		- 40 ~ + 85	°C
保存温度	T _{stg}		- 55 ~ + 150	°C
入力電力	P _{in}	T _A = +25°C	0	dBm

注 50 × 50 × 1.6 mm 両面銅箔ガラス・エポキシ基板実装時

推奨動作範囲

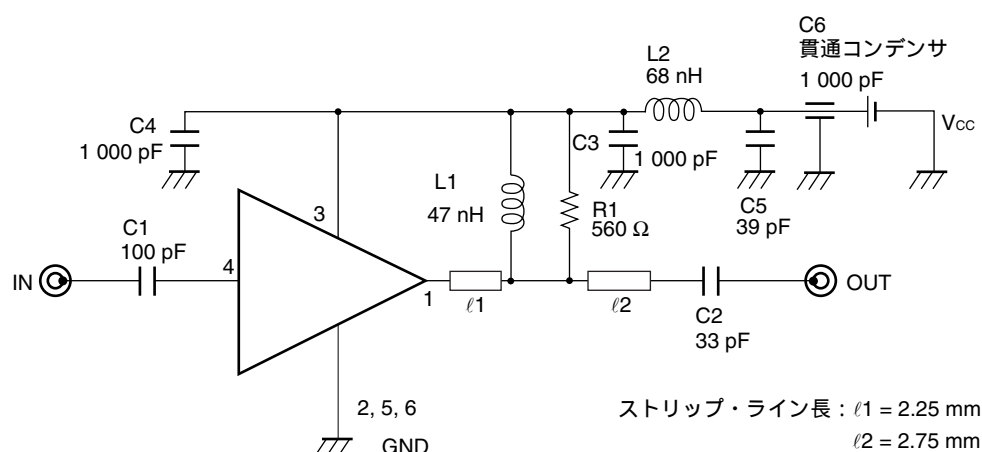
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
電源電圧	V _{CC}		4.5	5.0	5.5	V
動作周囲温度	T _A		- 40	+ 25	+ 85	°C

Not recommended
for new design

電気的特性 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = V_{out} = 5.0\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
回路電流	I _{CC}	無信号時	20	26	32	mA
電力利得 1	G _{P1}	f = 0.25 GHz, P _{in} = - 35 dBm	29	31.5	34	dB
電力利得 2	G _{P2}	f = 1.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	30	32.8	35.5	
電力利得 3	G _{P3}	f = 1.8 GHz, P _{in} = - 35 dBm	31	33.8	37	
電力利得 4	G _{P4}	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	30.5	33.5	36.5	
電力利得 5	G _{P5}	f = 2.6 GHz, P _{in} = - 35 dBm	29	32.2	35.5	
電力利得 6	G _{P6}	f = 3.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	27	30.7	34	
ゲイン・フラットネス	Δ GP	f = 1.0 ~ 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	—	1.0	—	dB
K ファクタ 1	K1	f = 1.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	—	1.3	—	—
K ファクタ 2	K2	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	—	1.9	—	—
飽和出力電力 1	P _{O (sat)} 1	f = 1.0 GHz, P _{in} = 0 dBm	+ 13	+ 15.5	—	dBm
飽和出力電力 2	P _{O (sat)} 2	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 5 dBm	+ 9.5	+ 12	—	
1 dB 利得圧縮時出力電力 1	P _{O (1 dB)} 1	f = 1.0 GHz	+ 8	+ 11	—	dBm
1 dB 利得圧縮時出力電力 2	P _{O (1 dB)} 2	f = 2.2 GHz	+ 6	+ 8.5	—	
雑音指数 1	NF1	f = 1.0 GHz	—	4	4.8	dB
雑音指数 2	NF2	f = 2.2 GHz	—	4.1	4.9	
アイソレーション 1	ISL1	f = 1.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	36	41	—	dB
アイソレーション 2	ISL2	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	38	45	—	
入力側リターン・ロス 1	RL _{in} 1	f = 1.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	9.5	13	—	dB
入力側リターン・ロス 2	RL _{in} 2	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	10	14.5	—	
出力側リターン・ロス 1	RL _{out} 1	f = 1.0 GHz, P _{in} = - 35 dBm	12	15.5	—	dB
出力側リターン・ロス 2	RL _{out} 2	f = 2.2 GHz, P _{in} = - 35 dBm	12	15	—	
入力 3 次ひずみ インタセプト・ポイント 1	IIP ₃ 1	f ₁ = 1 000 MHz, f ₂ = 1 001 MHz	—	- 9	—	dBm
入力 3 次ひずみ インタセプト・ポイント 2	IIP ₃ 2	f ₁ = 2 200 MHz, f ₂ = 2 201 MHz	—	- 15.5	—	
出力 3 次ひずみ インタセプト・ポイント 1	OIP ₃ 1	f ₁ = 1 000 MHz, f ₂ = 1 001 MHz	—	+ 23.5	—	dBm
出力 3 次ひずみ インタセプト・ポイント 2	OIP ₃ 2	f ₁ = 2 200 MHz, f ₂ = 2 201 MHz	—	+ 18	—	
2 次相互変調ひずみ	IM ₂	f ₁ = 1 000 MHz, f ₂ = 1 001 MHz, P _{out} = - 5 dBm/tone	—	50	—	dBc
2 次高調波比	2f ₀	f ₀ = 1.0 GHz, P _{out} = - 15 dBm	—	70	—	dBc

測定回路図



本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

電気的特性測定部品表

	形 状	値
R1	チップ抵抗	560 Ω
L1	チップ・インダクタ	47 nH
L2	チップ・インダクタ	68 nH
C1	チップ・コンデンサ	100 pF
C2	チップ・コンデンサ	33 pF
C3, C4	チップ・コンデンサ	1 000 pF
C5	チップ・コンデンサ	39 pF
C6	貫通コンデンサ	1 000 pF

出力側へのインダクタ付加について

本 IC は内部出力段トランジスタに電流を供給することにより中出力が得られるように設計されています。そこで V_{CC} 端子 (3 ピン) と出力端子 (1 ピン) 間にインダクタを接続してください。インダクタンスの値としては上記部品表のような値を選んでください。

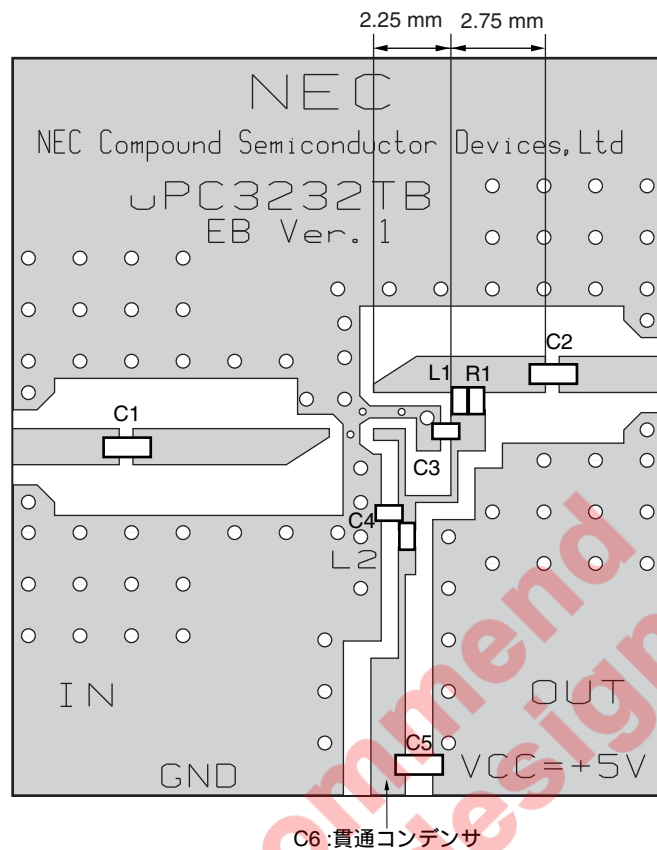
このようにインダクタを接続する目的は、DC 的な効果と、AC 的な効果を意図しています。DC 的には出力段の電圧降下を最小にしながら出力段トランジスタへの DC バイアス印加を可能にし、高い出力を得ます。AC 的には出力端子からインダクタンスで GND に落としているのと同じで、この値を大きくすることによりハイ・インピーダンス負荷になり、十分なゲインを得ています (搭載位置については次ページ参照)。

 V_{CC} 端子、入力端子へのコンデンサの決定について

V_{CC} 端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は、 V_{CC} 端子と GND 間のインピーダンスを 0 Ω に近づけるためです。これにより、電源電圧変動に対し、安定したバイアス状態にすることができます。

入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は、入出力端子と外付け回路を DC 的にカットするためで、50 Ω の負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。このコンデンサがハイパス・フィルタとなり、DC までの低い周波数をロスさせる訳です。

測定回路のプリント基板例



部品表

	値	サイズ
R1	560 Ω	1005
L1	47 nH	1005
L2	68 nH	1005
C1	100 pF	1608
C2	33 pF	1608
C3, C4	1 000 pF	1005
C5	39 pF	1608
C6	1 000 pF	貫通コンデンサ

基板例注釈

(* 1) 19 × 21.46 × 0.51 mm RO4003C (Rogers) に両面 18 μm 厚銅パ

ターニング

(* 2) 裏面グラウンド・パターン

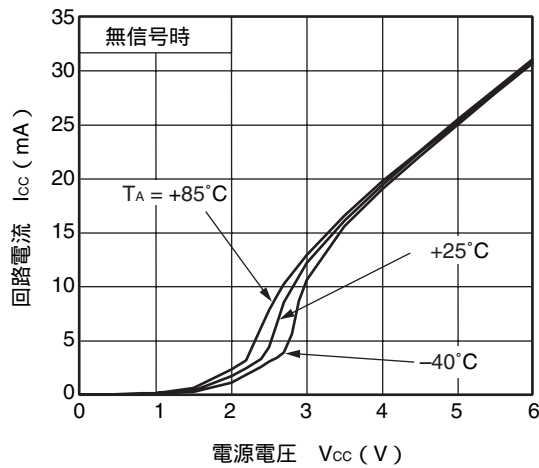
(* 3) パターニング面は Au メッキ

(* 4) ◯ ◯ はスルー・ホール

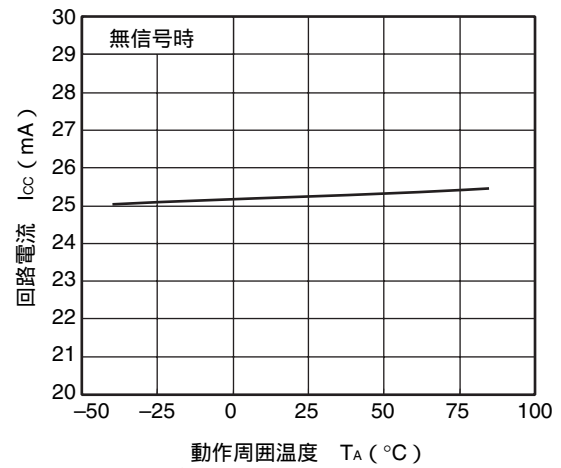
(* 5) L1, L2 は FDK 製

特性曲線（特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$, 参考値）

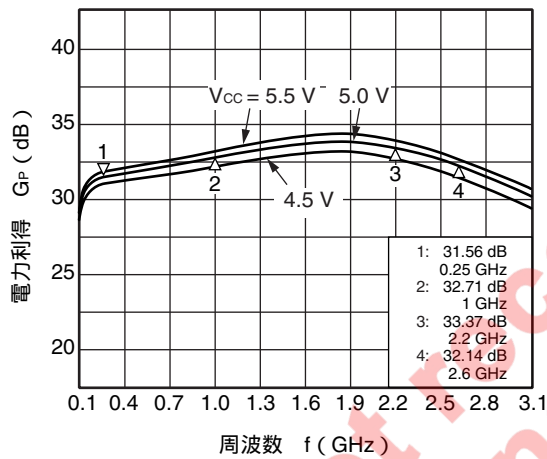
回路電流 vs. 電源電圧



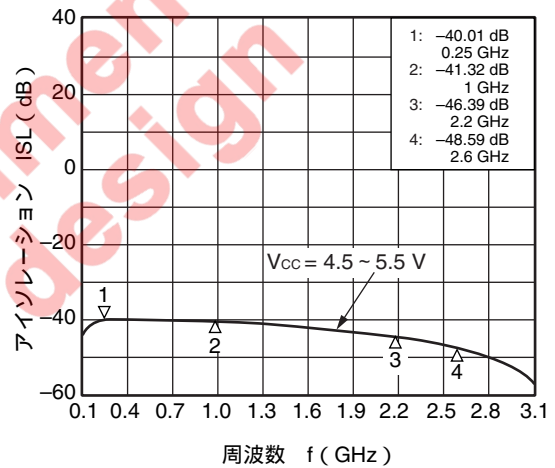
回路電流 vs. 動作周囲温度



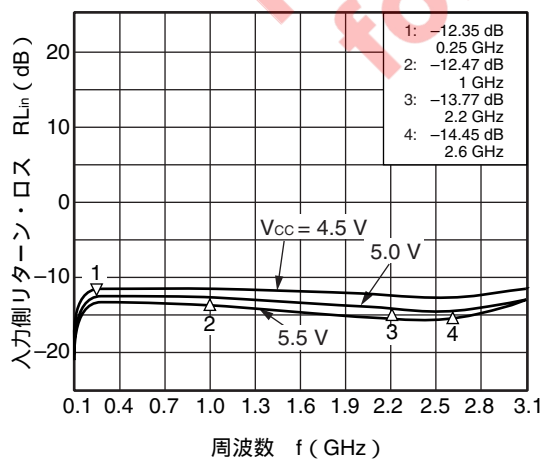
電力利得 vs. 周波数



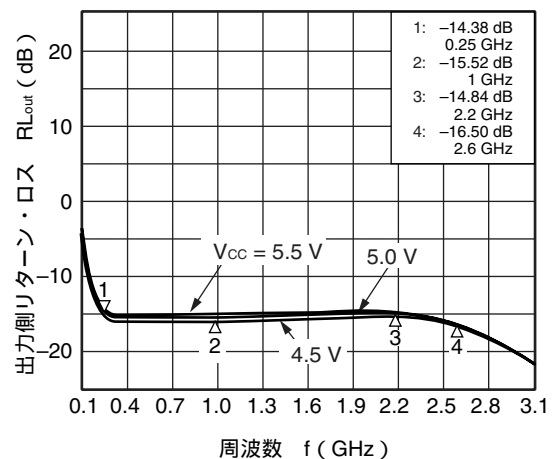
アイソレーション vs. 周波数



入力側リターン・ロス vs. 周波数

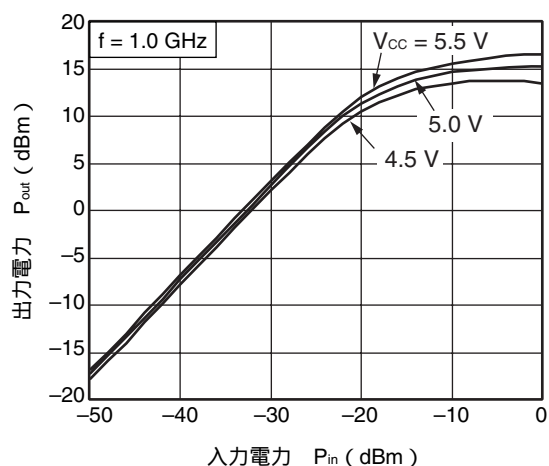


出力側リターン・ロス vs. 周波数

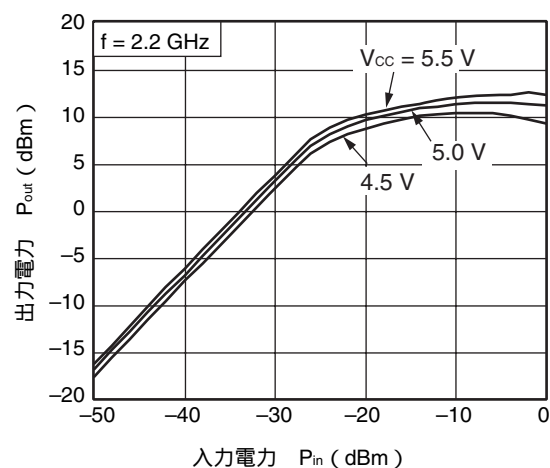


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

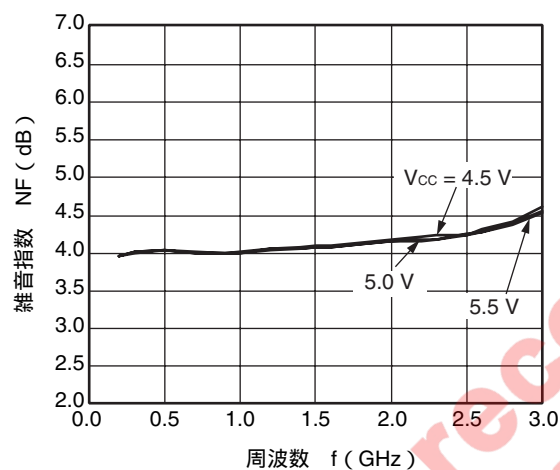
出力電力 vs. 入力電力



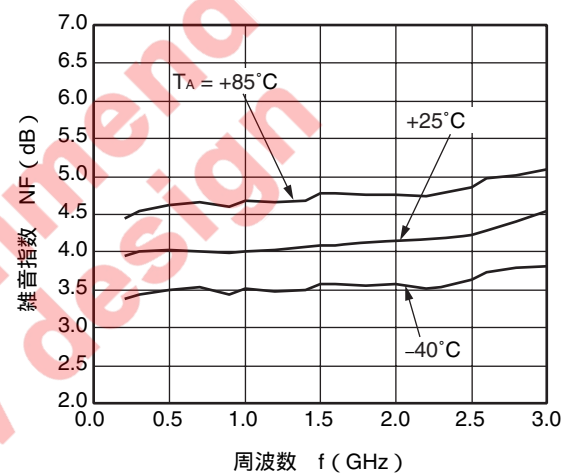
出力電力 vs. 入力電力



雑音指数 vs. 周波数

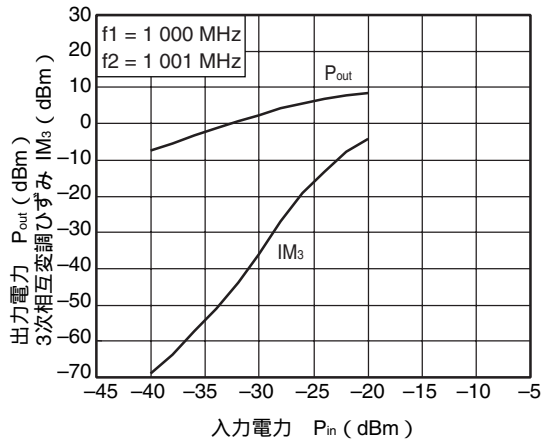


雑音指数 vs. 周波数

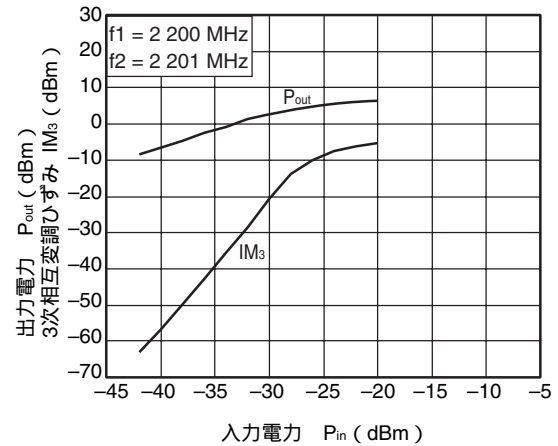


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

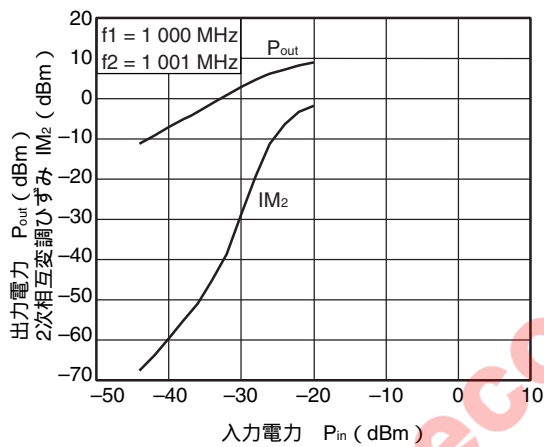
出力電力，3次相互変調ひずみ vs. 入力電力



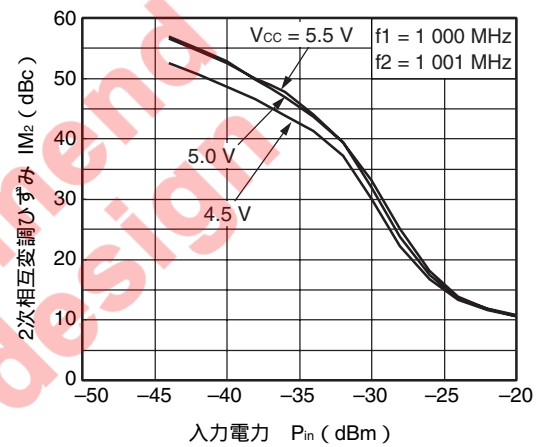
出力電力，3次相互変調ひずみ vs. 入力電力



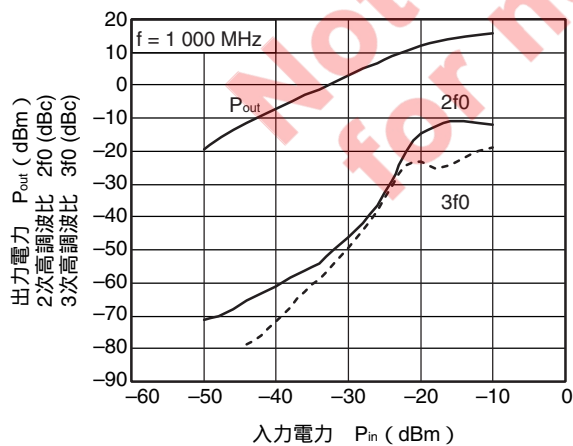
出力電力，2次相互変調ひずみ vs. 入力電力



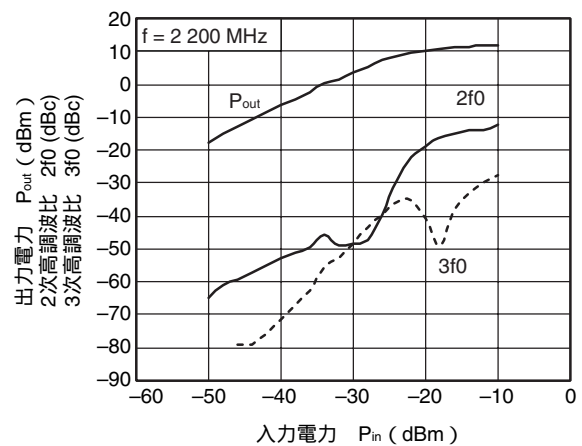
2次相互変調ひずみ vs. 入力電力



出力電力，2次高調波比，3次高調波比 vs. 入力電力



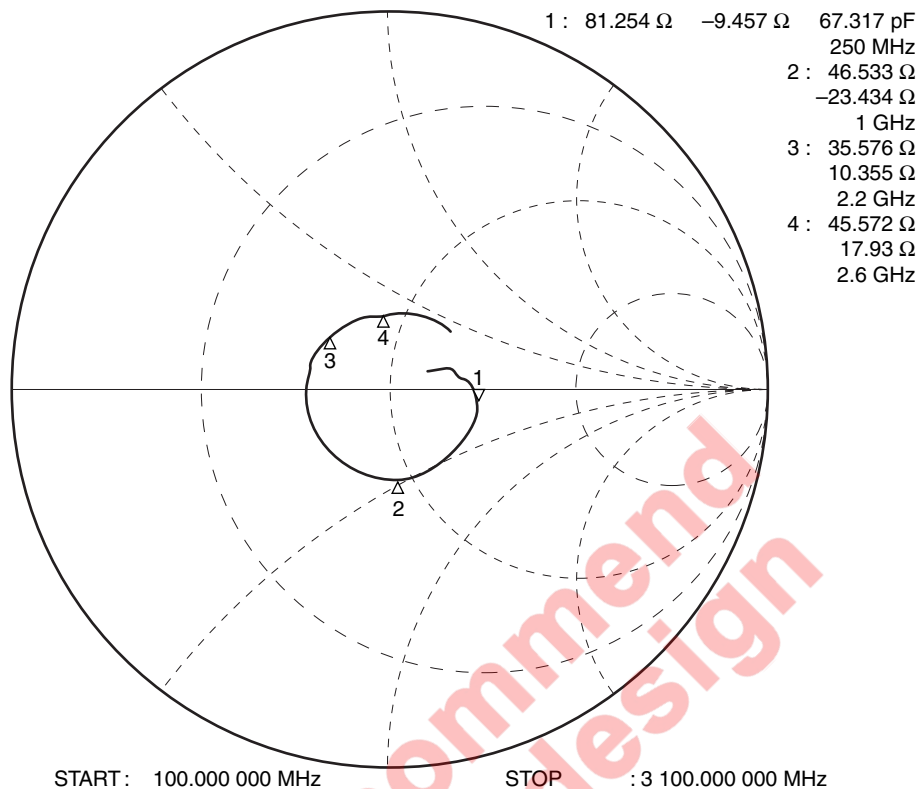
出力電力，2次高調波比，3次高調波比 vs. 入力電力



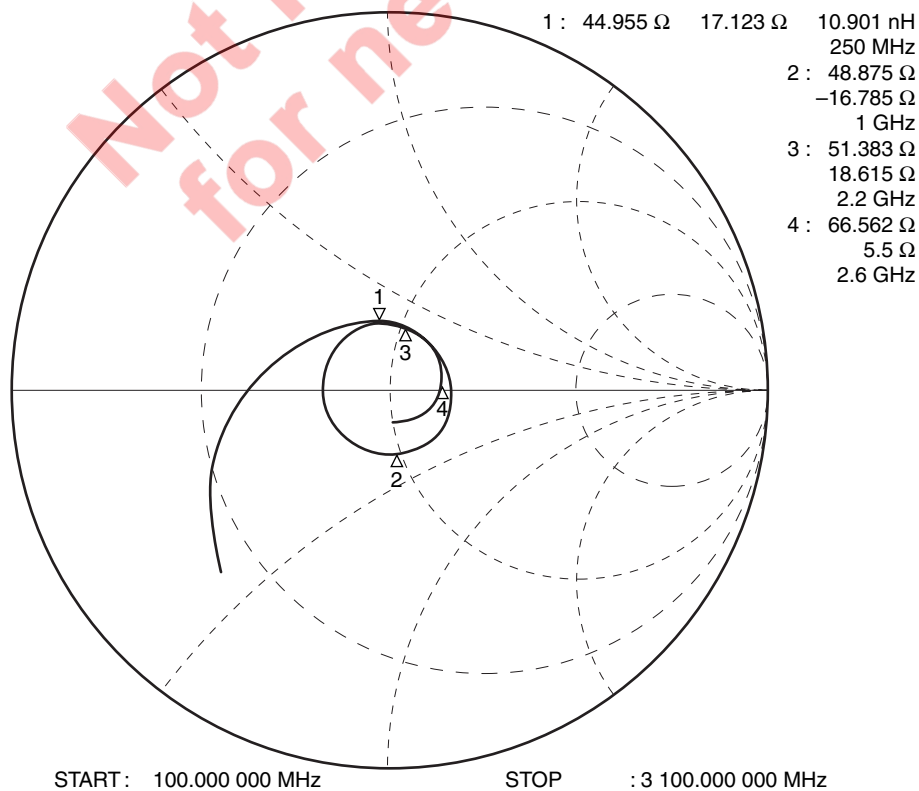
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

Sパラメータ (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = V_{CC} = 5.0\text{ V}$, $P_{in} = -35\text{ dBm}$)

S₁₁-周波数



S₂₂-周波数



S パラメータ

Sパラメータ/ノイズ・パラメータは当(事)Webサイトにて、シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式で提供しております。

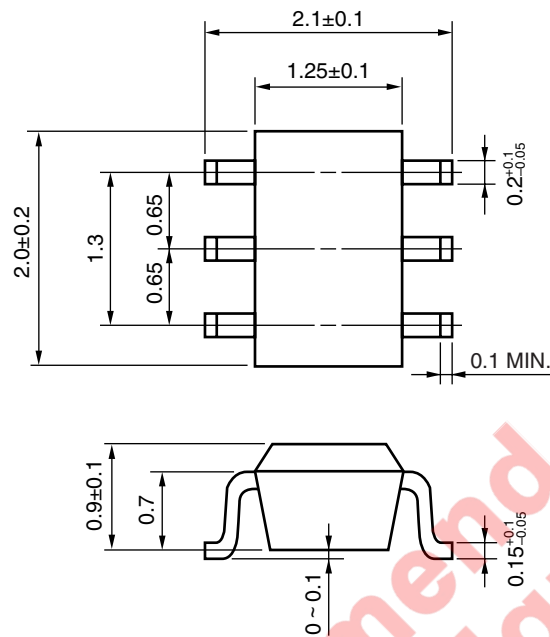
[RF&マイクロ波] → [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして、ご利用ください。

URL http://www.ncsd.necel.com/microwave/index_j.html

Not recommend
for new design

外形図

6ピン小型ミニモ - ルド (単位 : mm)



使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) V_{CC} 端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 出力端子と V_{CC} 端子間インダクタ (L) を挿入してください。インダクタンス値は使用周波数に応じて決定してください。
- (5) 各信号入出力端子はそれぞれカップリング・コンデンサなどで DC カットしてください。

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 260°C 以下 ・ 最高温度の時間 : 10 秒以内 ・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒 ・ 最ドリフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下	IR260
ウェーブ・ソルダリング	・ 最高温度 (溶融半田温度) : 260°C 以下 ・ フロー時間 : 10 秒以内 ・ プリヒート温度 (パッケージ表面温度) : 120°C 以下 ・ フロー回数 : 1 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下	WS260
端子部分加熱	・ 最高温度 (端子部温度) : 350°C 以下 ・ 時間 (デバイスの一辺あたり) : 3 秒以内 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください (ただし、端子部分加熱は除く)。

- 本資料に記載されている内容は2006年5月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

（注）

- （１）本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- （２）本事項において使用されている「当社製品」とは、（１）において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

NECエレクトロニクス株式会社 化合物デバイス事業部

http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先（購入、サンプル、品質、RoHSなど）

E-mail : csd_salesinfo@ml.necel.com TEL : 044-435-1838

技術に関する問い合わせ先（規格、特性、使い方など）

E-mail : csd_techinfo@ml.necel.com TEL : 044-435-1577

問い合わせサイト : https://e-sv.ncsd.necel.com/ncsd/contact/techinfo_form_j.html